



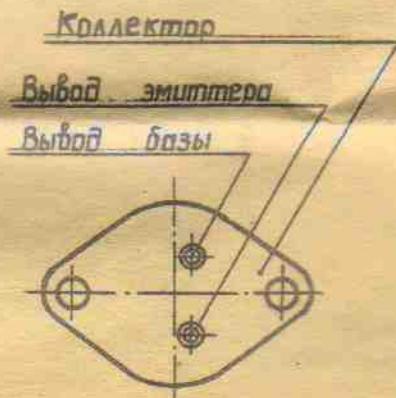
Транзистор 2Т709

Э Т И К Е Т К А

Кремниевые меза - пленарные р-п-р составные транзисторы типов 2Т709А, 2Т709Б, 2Т709В в металлическом корпусе с изоляторами типа КТ-8 ГОСТ 18472-82, предназначенные для работы в ключевых и линейных схемах

Климатическое исполнение УХЛ

Схема расположения выводов



А.122-КТД 13.02.89

Основные электрические параметры

при $t_{окр} = +25^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, тип транзистора, режим измерения	Буквенное обозна- чение	Норма	
		не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером 2Т709А 2Т709Б, 2Т709В ($U_{кБ} = 5 \text{ В}$, $I_3 = 5 \text{ А}$)	β_{213}	500 750	
Граничное напряжение, В 2Т709А 2Т709Б 2Т709В ($I_3 = 0,1 \text{ А}$, $\tau_n \leq 300 \text{ мкс}$, $Q > 100$)	$U_{кв0гр}$	80 60 40	
Пробивное напряжение коллектор- база, В 2Т709А 2Т709Б 2Т709В ($I_к = 0,001 \text{ А}$)	$U_{кб0 проб}$	100 80 60	
Пробивное напряжение эмиттер-база, В 2Т709А, 2Т709Б, 2Т709В ($I_3 = 0,005 \text{ А}$)	$U_{эб0 проб}$	5	
Напряжение насыщения коллектор- эмиттер, В 2Т709А, 2Т709Б, 2Т709В ($I_к = 5 \text{ А}$, $I_г = 0,02 \text{ А}$)	$U_{кэ нас}$		2
Напряжение насыщения база - эмиттер, В 2Т709А, 2Т709Б, 2Т709В ($I_к = 5 \text{ А}$, $I_б = 0,02 \text{ А}$)	$U_{бэ нас}$		3

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. транзисторов

золото 5.7608 г

серебро 40.6100 г

Цветных металлов не содержится

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы 2Т709А, 2Т709Б, 2Т709В соответствуют техни-
ческим условиям АГО.339.144 ТУ

Приняты по извещению № 123 от 20.6.89
дата

Место для
штампа ОТК



Место для штампа
представителя заказчика

Место для штампа "Перепроверка произведена" _____
дата

Приняты по извещению № _____ от _____
дата

Место для
штампа ОТК

Место для штампа
представителя заказчика